

Máquina De Diamante Mpcvd Com Ressonador De Jarro De Sino Para Laboratório E Crescimento De Diamante

Número do item: KTMP315



introdução

Obtenha películas de diamante de alta qualidade com a nossa máquina MPCVD com ressonador de jarro de sino, concebida para laboratório e crescimento de diamantes. Descubra como a Deposição de Vapor Químico por Plasma de Micro-ondas funciona para o crescimento de diamantes usando gás carbónico e plasma.

[Saiba mais](#)

Sistema de micro-ondas	<ul style="list-style-type: none"> Frequência de micro-ondas $2450 \pm 15\text{MHz}$, Potência de saída $1\text{--}10\text{ KW}$ continuamente ajustável Estabilidade da potência de saída de micro-ondas: $<\pm 1\%$ Fuga de micro-ondas $\leq 2\text{MW/cm}^2$ Interface de guia de onda de saída: WR340, 430 com flange padrão FD-340, 430 Fluxo de água de arrefecimento: $6\text{--}12\text{L/min}$ Coeficiente de onda estacionária do sistema: $\text{VSWR} \leq 1,5$ Ajustador manual de micro-ondas de 3 pinos, cavidade de excitação, carga de alta potência Fonte de alimentação de entrada: $380\text{VAC}/50\text{Hz} \pm 10\%$, trifásico
Câmara de reação	<ul style="list-style-type: none"> Taxa de fuga de vácuo $<5 \times 10^{-9}\text{ Pa .m}^3/\text{s}$ A pressão limite é inferior a $0,7\text{ Pa}$ (configuração normalizada com um vacuômetro Pirani) O aumento da pressão da câmara não deve exceder 50Pa após 12 horas de manutenção da pressão Modo de funcionamento da câmara de reação: Modo TM021 ou TM023 Tipo de cavidade: Cavidade ressonante em borboleta, com uma potência máxima de suporte de 10KW, fabricada em aço inoxidável 304, com camada intermédia arrefecida a água e método de vedação com placa de quartzo de elevada pureza. Modo de entrada de ar: Entrada de ar uniforme anular superior Selagem a vácuo: A ligação inferior da câmara principal e a porta de injeção são seladas com anéis de borracha, a bomba de vácuo e os foles são selados com KF, a placa de quartzo é selada com um anel C metálico e o resto é selado com CF Janela de observação e de medição da temperatura: 4 portas de observação Porta de carregamento de amostras na frente da câmara Descarga estável dentro da gama de pressão de $0,7\text{KPa} \sim 30\text{KPa}$ (a pressão de alimentação deve ser igualada)
Suporte de amostras	<ul style="list-style-type: none"> Diâmetro da mesa de amostras $\geq 70\text{mm}$, área de utilização efectiva $\geq 64\text{ mm}^2$ Estrutura sanduíche refrigerada a água da plataforma da placa de base O suporte da amostra pode ser levantado e abaixado uniformemente eletricamente na cavidade
Sistema de fluxo de gás	<ul style="list-style-type: none"> Disco de ar para soldadura de todos os metais Devem ser utilizadas juntas de soldadura ou VCR para todos os circuitos internos de gás do equipamento. Medidor de caudal MFC de 5 canais, H₂/CH₄/O₂/N₂/Ar. H₂: 1000 sccm ;CH₄:100 sccm; O₂: 2 sccm; N₂: 2 sccm; Ar: 10 sccm Pressão de trabalho $0,05\text{--}0,3\text{MPa}$, precisão $\pm 2\%$ Controlo independente da válvula pneumática para cada canal do medidor de caudal
Sistema de arrefecimento	<ul style="list-style-type: none"> 3 linhas de arrefecimento a água, monitorização em tempo real da temperatura e do caudal. O caudal de água de arrefecimento do sistema é $\leq 50\text{L/min}$ A pressão da água de resfriamento é $<4\text{KG}$ e a temperatura da água de entrada é de $20\text{--}25\text{ }^\circ\text{C}$.

Sensor de temperatura

- O termômetro infravermelho externo tem uma faixa de temperatura de 300-1400 °C
- Precisão do controle de temperatura <2 °C ou 2%

Sistema de controlo

- Siemens smart 200 PLC e controle de tela de toque são adotados.
- O sistema possui uma variedade de programas, que podem realizar o equilíbrio automático da temperatura de crescimento, controle preciso da pressão do ar de crescimento, aumento automático de temperatura, queda automática de temperatura e outras funções.
- A operação estável do equipamento e a proteção abrangente do equipamento podem ser alcançadas através da monitorização do fluxo de água, temperatura, pressão e outros parâmetros, e a fiabilidade e segurança da operação podem ser garantidas através do encravamento funcional.

Função opcional

- Sistema de monitorização central
- Potência de base do substrato